

高純度Ptfе製ウェット洗浄フラワーバスケット

シングルウェハエッチングラック カスタマイズ可能

4インチマスクプレートキャリア

商品番号: PL-CP66



前書き

高純度PTFE製ウェット洗浄フラワーバスケットは、半導体ウェハ加工において優れた耐薬品性を発揮します。このカスタマイズ可能なエッチングラックは、要求の厳しい研究室や産業環境において、繊細な基板の汚染のない浸漬洗浄とハンドリングを実現します。特注フッ素ポリマーソリューションはお問い合わせください。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
半導体ウェハ洗浄	有機汚染や金属汚染を除去するためのRCAクリーン（SC-1およびSC-2）シーケンスでのシリコンウェハの浸漬処理	交差汚染を防止し、高純度な加工を実現
ウェットケミカルエッチング	高温のフッ化水素酸またはリン酸浴を使用した薄膜（SiO ₂ 、Si ₃ N ₄ ）の精密エッチング	攻撃性の高い酸環境下で構造的完全性を維持
マスクプレート加工	リソグラフィで使用されるフォトマスクの専門的なハンドリングと洗浄を行い、欠陥のないパターン転写を実現	精密なスロット加工により、マスク表面への接触による損傷を防止
太陽電池製造	テクスチャリングおよびリンケイ酸ガラス（PSG）除去のためのシリコンウェハのバルク処理	大量生産サイクルにおいて高い処理能力と耐久性を発揮
導電性ガラスの前処理	オプトエレクトロニクスおよびディスプレイ製造向けITO/FTOコートガラスの洗浄と前処理	接点が少ないため、繊細な導電層の傷つきを防止
MEMS開発	複雑な犠牲層エッチング工程における多層微細電気機械システムのハンドリング	化学的不活性により、繊細な微細構造の損傷を防止
実験室規模の研究開発	新規材料開発のための、大学・産業研究における小ロットでの基板処理	柔軟なカスタマイズにより、規格外の基板形状・サイズに対応可能

パラメータ	仕様詳細（モデル：PL-CP66）
素材構成	100% 高純度バージンPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
最大使用温度	+260°C（連続使用）
最小使用温度	-200°C
薬品適合性	ユニバーサル（pH 0-14）；HF、王水、ピラニア溶液に耐性あり
標準基板サイズ	4インチ（100mm） - あらゆる直径にカスタマイズ可能
スロット構成	シングルウェハまたはマルチウェハのバリエーションあり

パラメータ	仕様詳細（モデル：PL-CP66）
スロット深さ/幅	基板の厚さと安定性のニーズに応じてフルカスタマイズ可能
ハンドル設計	固定式垂直、着脱式、スイング式ハンドル（いずれもカスタマイズ可能）
製造方法	精密CNC加工（成形汚染ゼロ）
表面仕上げ	高光沢、低多孔性の機械加工仕上げ